

氮化鎵高電子移動率 電晶體

國立中山大學

公告日

2021/10/01

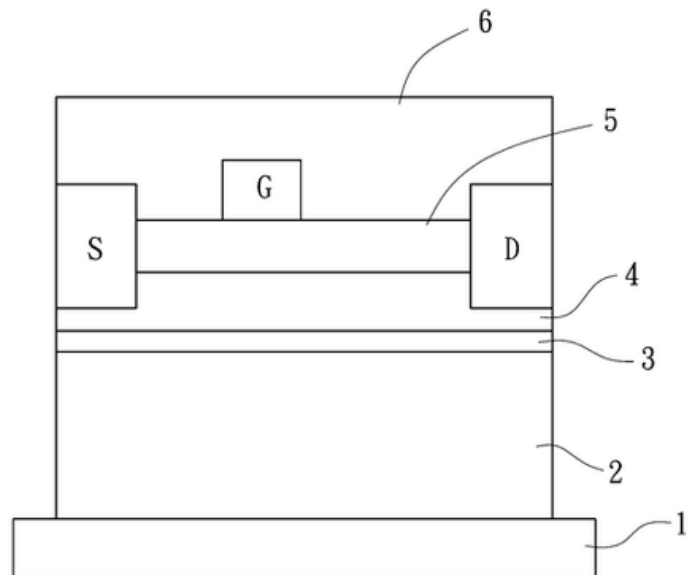
證書號

I741834

發明人

張鼎張 (中華民國); 國立中山大學 物理系 教授

團隊成員：陳宏誌、鄭皓軒、林妤珊、金福源、邱豐閔、林昀萱、戴茂洲



摘要

一種氮化鎵高電子移動率電晶體，用以解決習知氮化鎵高電子移動率電晶體為抑制扭結效應而增加製造成本及功率消耗的問題。係包含：一基板；一緩衝層，位於該基板上；一阻擋層，疊層於該緩衝層上，該阻擋層是p型半導體或寬能隙材料；一通道層，疊層於該阻擋層上；及一供應層，疊層於該通道層上，一閘極位於該供應層上，一源極及一汲極分別電連接該通道層及該供應層。

中華民國專利資訊檢索系統

可點選上方連結依證書號或名稱查詢相關資訊相關資訊